

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成20年4月24日 (2008.4.24)

【公開番号】特開2006-241520(P2006-241520A)

【公開日】平成18年9月14日 (2006.9.14)

【年通号数】公開・登録公報2006-036

【出願番号】特願2005-59081(P2005-59081)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/455 (2006.01)

C 2 3 C 16/34 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

【 F I 】

C 2 3 C 16/455

C 2 3 C 16/34

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/88 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月28日 (2008.2.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 4 9 】

真空チャンバ 1 1 の上方で、基板ホルダー 1 3 に対向する位置にターゲット 1 8 が設置されている。ターゲット 1 8 には、その表面をスパッタリングし、ターゲット構成物質の粒子を放出させるプラズマを発生させるための電圧印加装置 1 9 が接続されている。なお、ターゲット 1 8 は、上記原料ガスに含まれる金属の構成元素 (T a) を主成分とするもので構成されている。この電圧印加装置 1 9 は、直流電圧発生装置 1 9 1 と、ターゲット 1 8 に接続された電極 1 9 2 とから構成されている。この電圧印加装置は、直流電圧発生装置 1 9 1 の代わりに、直流に交流を重ねさせたものを有していてもよい。また、基板ホルダーに高周波発生装置が接続されていて、バイアスが印加できるような形でもよい。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

[illegible]